

K. Memory (Design & Process Technology) 분과

Room B
창의관 (110)

일 시 : 2월 17일(금) 09:30-11:00

세션명 : [FB1-K] Memory Design Technologies

좌 장 : 강희복(하이닉스반도체), 최우영(삼성전자)

-
- FB1-K-1 09:30-10:00 **[Invited]** Mobile Storage Overview
저자: 강용훈
소속: 삼성전자 Memory 상품기획팀
- FB1-K-2 10:00-10:15 SRAM disturb 특성 향상을 위한 β ratio 개선
저자: 김승준, 양태규, 김용훈, 김운용, 홍명희, 박용복, 김성환,
한정욱
소속: 삼성전자 System LSI사업부 Foundry사업팀 PIE팀 PIE²그룹
- FB1-K-3 10:15-10:30 On-Chip Regulator with Very High PSRR for Low Noise Applications
저자: 강신덕, 김용주
소속: 하이닉스반도체 설계기반기술팀
- FB1-K-4 10:30-10:45 On-Chip Decoupling Capacitor 최적 설계를 통한 DDR3 메모리의 Power Noise 감소
저자: 정부호, 이준호, 김현석, 조선기, 김양희
소속: 하이닉스 반도체 선행설계팀